•光电器件与材料•

CdZnSe 量子点非线性光学性能研究

潘茂森',赵明辉',牟晓勇',余大斌',黄国畅',赵大鹏',张金花',杜 凯'

(1.电子工程学院 脉冲功率激光技术国家重点实验室,合肥 230037;2.西安航天动力研究所,西安 710100;3.73682 部队,江苏 徐州 221000)

摘 要:介绍了CdZn₁₋Se量子点的制备方法、形貌、组成以及表征,并对其非线性光学进行了研究。结果表明,CdZn₁₋Se量子点呈现自散焦特性,具有良好的非线性性能,尤其,其光学非线性参数可通过化学组成进行调节。因此,CdZn₁₋Se量子点在激光防护、光电开关等方面具有重要的潜在应用价值。

关键词:CdZnSe;量子点;非线性光学特性;自散焦特性
 中图分类号:0614
 文献标识码:A
 文章编号:1673-1255(2016)-05-0022-05

Research on Nonlinear Optical Property of CdZnSe Quantum Dots

PAN Mao-sen¹, ZHAO Ming-hui¹, MOU Xiao-yong², YU Da-bin¹, HUANG Guo-chang¹, ZHAO Da-peng¹, ZHANG Jin-hua¹, DU Kai¹

(1. State Key Laboratory of Pulsed Power Laser Technology, Electronic Engineering Institute, Hefei 230037, China;
 2. Xi 'an Aerospace Propulsion Institute, Xi 'an 710100, China;
 3. 73682 Army Unit, Xuzhou 221000, China)

Abstract: The preparation method, morphologies, composition and characterization of $Cd_xZn_{1-x}Se$ quantum dots are introduced, and the nonlinear optical properties are researched. Research results show that the $Cd_xZn_{1-x}Se$ quantum dots exhibit self defocusing property and have good nonlinear optical performance, particularly, their nonlinear optical parameters can be adjusted by controlling their chemical compositions. Thus, $Cd_xZn_{1-x}Se$ quantum dots have potential applications in the fields such as laser protection and photoelectric switches.

Key words: CdZnSe; quantum dots; nonlinear optical properties; self defocusing property

量子点具有显著的量子效应,在太阳能电池^{III}、 激光器^{III}、生物标记^{III}、非线性光学材料^{III}等领域具有 广泛的应用价值。目前,三元量子点成为当前诸多 领域共同关注的焦点,这是因为,与二元量子点相 比,三元量子点的化学组成可调,可以通过化学组 成调整获得更加优越的性能。

目前,三元量子点的研究仍然集中在可控合成 和特性两个方面。三元量子点的合成可以借鉴纳 米粒子的常用合成方法,如微乳液法^[5]、模板法^[6]、胶 体化学法^[7-8]、溶剂热法^[9-10]、有机金属合成法^[11-12]等。 虽然这些方法是合成三元量子点的常用技术途径, 但是能够实现大量、可控合成的方法并不多见。另 一方面,关于三元量子点的特性研究主要集中在其 荧光增强、能隙蓝移、激子增强等方面^[13-15],尤其是 其非光学特性引起了人们的关注。

采用改进的"一锅煮"合成法^[16],成功地实现了 Cd_xZn_{1-x}Se 三元量子点的大量、可控合成,并在此基 础上开展非线性光学特性研究。根据文献资料来 看,尚未见类似研究的报道。

1 CdxZn_{1-x}Se量子点的制备

量子点的制备过程如下

(1)将一定量的Se粉和适量的油酰基吗啡啉加

收稿日期:2016-10-02

作者简介:潘茂森(1993-),男,安徽亳州人,硕士研究生,主要研究方向为光电工程功能材料.

人到容量为25 ml的烧杯中,在磁力搅拌的情况下 加热至140℃直到Se完全溶解于油酸基吗啡啉为 止,随后冷却至120℃,获得Se前驱液,待用。

(2)在一个容量为25 ml 三颈瓶中加入与硒前 驱物化学计量相同的CdO粉末和ZnO粉末,并同时 加入适量的油酸和十八烯,在N₂保护下持续搅拌, 并将混合物加热至250℃直至CdO粉末和ZnO粉末 完全溶解为止,然后降温至120℃。将上述Se前驱 液加入到三颈瓶中,在N₂保护下缓慢加热到140℃, 持续搅拌1h,随后快速升温至210℃,并在此温度 下维持反应10 min。

(3)将上述三颈瓶中反应后的混合物倒入到装 有 20 ml 甲苯的烧杯中,加入适量的甲醇析出深沉, 并用离心机进行分离。

根据上述步骤操作,改变Zn和Cd的摩尔比,即可获得不同化学组分的Cd、Zn₁、Se量子点。

2 CdxZn_{1-x}Se量子点的组成与结构表征

图1为不同组分的CdxZn_{1-x}Se量子点的XRD测试图谱。



图1 不同组分的Cd₂Zn_{1-s}Se量子点的XRD图谱 (A)ZnSe,(B)Cd_{0.19}Zn_{0.81}Se,(C)Cd_{0.42}Zn_{0.58}Se,(D) Cd_{0.68}Zn_{0.32}Se,(E)CdSe

图 1(A-E) 是所制备的 Cd_xZn_{1-x}Se 量子点随 Cd/ Zn 比例变化的 XRD 谱图。XRD 图谱中的三个最强 衍射峰分别对应着 Cd_xZn_{1-x}Se 量子点的(111)、 (220)、(311)三个晶面。可以看出,随着 Cd元素含 量的增加,三个衍射峰逐步向小角度偏移。这是因 为,Cd²⁺的半径大于 Zn²⁺的半径,随着 Cd 组分的增 加,晶面间距逐渐增大,所以衍射峰的位置逐渐向 角度变小的方向偏移,这也说明产物是三元合金量 子点¹¹⁶¹。由 Deby-Scherrer 公式可计算出 Cd_xZn_{1-x}Se 量子点平均尺寸为大约为3.2 nm。

3 CdxZn_{1-x}Se量子点的形貌

图 2 是 Cd_xZn_{1-x}Se 量子点的高分辨透射电镜 (HRTEM)图片。



图 2 不同组分的 Cd₈Zn₁₋₈Se 量子点透射电镜图片 (A)ZnSe,(B)Cd_{0.19}Zn_{0.81}Se,(C)Cd_{0.42}Zn_{0.58}Se, (D)Cd_{0.68}Zn_{0.32}Se,(E)CdSe; (F)为 Cd_{0.42}Zn_{0.58}Se 量子点的EDS 图谱

由图2可以看出,量子点接近球形,平均半径约在3nm,小于CdSe(4.9nm)和ZnSe(4.5nm)的玻尔激子半径,即符合量子点的尺寸条件¹¹⁷¹。另外,图片中清楚的二维晶格条纹表明,所获得的Cd₂Zn₁₋₅Se量子点真有良好的结晶性。图2(F)是实际组分为Cd_{0.42}Zn_{0.58}Se量子点的EDS谱图,表明制备出的量子点是由Cd₂Zn和Se三种元素构成。在图2(A-E)中,右上插图分别为圆圈选中区域傅里叶变换的衍射图样,所有样品都具有相似的衍射花样,说明晶体

结构相同。图2(C)的右下插图为选中区域电子衍 射图片,由内向外的三个衍射环分别对应着量子点 的(111)、(220)、(311)三个晶面,与XRD分析结果 一致。

4 CdxZn_{1-x}Se量子点的吸收光谱

图 3 是不同组分的 Cd_xZn_{1-x}Se 量子点的紫外-可 见光吸收图谱。



图 3 不同组分 Cd₂Zn_{1-x}Se 量子点溶解于甲苯中的紫 外-可见光吸收图谱(a)ZnSe,(b)Cd_{0.19}Zn_{0.81}Se,(c) Cd_{0.42}Zn_{0.58}Se,(d)Cd_{0.68}Zn_{0.32}Se,(e)CdSe

可以看出,随着 Cd 组分的增加,量子点第一激 子吸收峰明显红移,从 370 nm 红移到 570 nm,随着 量子点中 Cd 组分的增加。其根本原因是 ZnSe 的禁 带宽度大于 CdSe 的禁带宽度,所以在三元量子点 中,随着 Cd 组分的增加,合金量子点的禁带宽度逐 渐减小,产生了吸收红移现象。

图4为Cd_xZn_{1-x}Se量子点hv和(αhv)²关系曲线。



图4 Cd₃Zn₁₋₃Se量子点hv和(αhv)²关系曲线 (A)ZnSe,(B)Cd_{0.19}Zn_{0.81}Se,(C)Cd_{0.42}Zn_{0.58}Se, (D)Cd_{0.68}Zn_{0.32}Se,(E)CdSe

根据图4中所得紫外-可见光吸收光谱数据,结 合公式: $(\alpha h \nu)^2 = k(h \nu - E_g)^2(其中,h \nu 是入射光子能$ $量;k是一常数; \alpha 是吸收系数; E_g 是禁带宽度),可以$ $计算不同组分的Cd_x Zn_1_x Se 量子点的禁带宽度^[18]。可$ $以得出, Zn Se、Cd_{0.19} Zn_{0.81} Se、Cd_{0.42} Zn_{0.58} Se、Cd_{0.68} Zn_{0.32} Se$ 和CdSe 量子点的禁带宽度分别为2.54 eV、2.43 eV、2.30 eV、2.22 eV 和2.12 eV。这是因为, CdSe 的禁带宽度要比 Zn Se 的禁带宽度窄, 所以随着 x 的增加, $Cd_x Zn_1_x Se 量子点禁带宽度随之逐渐减小, 致使三元$ 量子点的光谱特性与化学组分相关。

5 Cd_xZn_{1-x}Se量子点的非线性光学特性

图5是不同组分的Cd_xZn_{1-x}Se量子点开孔Z扫描 归一化实验曲线。





图5 不同组分Cd₃Zn_{1-x}Se量子点溶液开孔Z扫 描归一化实验曲线(A)ZnSe,(B)Cd_{0.19}Zn_{0.81}Se, (C)Cd_{0.42}Zn_{0.58}Se,(D)Cd_{0.08}Zn_{0.32}Se,(E)CdSe

可以看出,曲线是关于焦点对称的谷,表明材 料为反饱和吸收,吸收系数为正^{118]}。

图6是不同组分的Cd_xZn_{1x}Se量子点的闭孔/开 孔Z扫描实验曲线。





图6 不同Cd₄Zn₁₋₅Se量子点溶液Z扫描闭孔/开孔 归一化实验曲线(A)ZnSe,(B)Cd_{0.19}Zn_{0.81}Se,(C) Cd_{0.42}Zn_{0.58}Se,(D)Cd_{0.68}Zn_{0.32}Se,(E)CdSe;所测样品 (A-E)和图1中的(A-E)分别对应

可以看出,曲线先峰后谷,表明材料为自散焦 介质,折射系数为负^[18]。此外,三元 Cd_xZn_{1-x}Se 量子 点的峰谷差要大于二元量子点 CdSe 和 ZnSe 量子点 的峰谷差,这说明所制备的三元 Cd_xZn_{1-x}Se 量子点的 非线性效应要强于二元 CdSe 和 ZnSe 量子点。

根据Z扫描实验数据,可以计算Cd_xZn_{1-x}Se量子 点的非线性光学参数:非线性吸收系数(β)、非线性 折射率(n_2)和非线性极化率($\chi^{(3)}$)的值,结果如表1 所示。

表1 Cd_zZn_{1-x}Se量子点的非线性折射率 (n_2) 、 非线性吸收系数 (β) 和极化率 $(\chi^{(3)})$ 的值

$Cd_{x}Zn_{1-x}Se$	β /m/W	n_2 /esu	$\text{Im}(\chi^{\scriptscriptstyle (3)})$	$\operatorname{Re}(\chi^{\scriptscriptstyle{(3)}})$	$\chi^{\scriptscriptstyle (3)}\!(esu)$
ZnSe	8.63×10 ⁻¹¹	-3.06×10 ⁻¹¹	4.37×10 ⁻²⁰	-1.02×10 ⁻¹⁹	1.11×10 ⁻¹⁹
$Cd_{\scriptscriptstyle 0.19}Zn_{\scriptscriptstyle 0.81}Se$	7.88×10 ⁻¹⁰	-5.87×10 ⁻¹¹	3.99×10 ⁻¹⁹	-1.96×10 ⁻¹⁹	4.45×10 ⁻¹⁹
$Cd_{\scriptscriptstyle 0.42}Zn_{\scriptscriptstyle 0.58}Se$	8.29×10 ⁻¹⁰	-9.63×10 ⁻¹¹	4.29×10 ⁻¹⁹	-3.21×10 ⁻¹⁹	5.36×10 ⁻¹⁹
$Cd_{\rm 0.68}Zn_{\rm 0.32}Se$	8.78×10 ⁻¹⁰	-1.10×10 ⁻¹⁰	4.44×10 ⁻¹⁹	-3.67×10 ⁻¹⁹	5.76×10 ⁻¹⁹
CdSe	1.31×10 ⁻¹⁰	-8.56×10 ⁻¹¹	6.63×10 ⁻²⁰	-2.86×10 ⁻¹⁹	2.94×10 ⁻¹⁹

可以看出,三元Cd_xZn_{1-x}Se量子点比二元量子点 CdSe和ZnSe具有更大的非线性折射率和非线性极 化率。三元组分的量子点的非线性参数随Cd组分 的增加而逐渐增大,表明了Cd_xZn_{1-x}Se三元合金量子 点随组分改变而变化的非线性光学性质。

6 结 论

综上所述,通过"一锅煮"方法合成了 Cd_xZn_{1x}Se 量子点,通过调节 Cd和Zn 的摩尔投料比实现对目 标产物化学组成的控制,Z扫描实验表明,材料为自 散焦介质,折射系数为负,且三元组分的量子点的 非线性参数随Cd组分的增加而逐渐增大,表明了 Cd_xZn_{1-x}Se 三元合金量子点随组分改变而变化的非 线性光学性质。通过进一步的器件化研究, Cd_xZn_{1-x}Se量子点可望作为新型光学材料,在激光防 护等方面体现出重要应用价值。

参考文献

- Senensson S, Hoffmann E, Nakpathomkun N. Nonlinear thermovoltage in quantum dots[J]. New Journal of Physics, 2013, 15: 105011.
- Xu H X, Wang H L, Yan J Y, et al. Gain and linewidth enhancement factor of InAs/GaAs quantum-dot daser diodes
 [J]. Chinese Journal of Luminescence, 2015, 36(5):567-571.
- [3] Winter S, Zelinski M, Chauvat D. The second order nonlinear susceptibility of quantum confined semiconductors[J]. Journal of Physical Chemistey C, 2011, 115 (11): 4558-4563.
- [4] Humbert C, Dahi A ,Dalstein L, et al. Linear and nonlinear optical properties of functionalized CdSe quantum dots prepared by plasma sputtering and wet chemistry[J]. Journal of Colloid and Interface Science, 2015, (445): 69-75.
- [5] Mathew S, Saran AD, Bhardwa BS, et al. Size dependent optical properties of the CdSe- CdS core-shell quantum dots in the strong confinement regime[J]. Journal of applied physics, 2012, 111: 074312.
- [6] Li P, OVergaag K. Publisher note: variable orbital coupling in a two dime-nsional quantum-dot solid probed on a local scale[J]. Phys Rev Lett, 2006, 096-803.
- [7] Goncalves LF, Kanodarwala FK, Stride JA, et al. One-pot synthesis of CdS nanoparticles exhibiting quantum size effect prepared within a sol-gel derived ureasilicate matrix [J]. Optical Materials, 2013, 36: 186-190.
- [8] Sanz N, Baldeck P L, Ibanez A. Organic nanocrstals em-

bedded in sol get glasses for optical applications synthetic metals[J]. Chemical Physics Letters, 2000, 28: 189-192.

- [9] Lianos P, Thomas JK. Cadmium sulfide of small dimensions produced inverted micelles[J]. Chemical Physics Letters, 1986, 125: 299-302.
- [10] Zhao D, He ZK, Chan WH, et al. Synthesis and characterization of high quality water soluble near infrared emitting CdTe/CdS quantum dots capped by N-acetyl cysteine via hydrothermal method[J]. The Journal of Physical Chemistry C, 2009, 113: 1293-1300.
- [11] Bai YJ, Liu ZG, Xu XG, et al. Preparation of InN nanocrystals by solvothermal method[J]. Jorunal of Crystal Growth, 2002, 241: 189-192.
- [12] Shen FY, Que WX, Yin XT, et al. A facile method to synthesize high quality ZnS (Se) quantum dots for photolumin-escence[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2011, 509: 9105-9110.
- [13] Bakker, Morten P, Ruytenberg, et al. Quantum dot nonlinarity through cavity-enhanced feed back with a charge memory[J]. Physical Review, 2015, 91(24): 241305.
- [14] Sun Q J,Wang ,Andrew Y, et al. Multicoloured light-emitting diodes based on quantum dots[J]. Nature Photonics, 2007, 1(12): 717-722.
- [15] Medintz I L,Uyeda H T, Goldman E , et al. Quantun dot bioconjugates for imaging, labelling and sensing[J]. Nature Materials, 2005, 4(6): 435-446.
- [16] Dabin Yu, Kai Du, ZHANG Jin-hua, et al. Compositiontunable nonlinear optical properties of alloy ternary Cd-SexS1-x (x =0-1) quantum dots [J]. NewJ Chem, 2014, 38: 5081.
- [17] 杜凯,张金花,王峰.Ⅱ-Ⅵ族量子点的制备和非线性光 学性质研究进展[J].材料导报,2013,27:38-42.
- [18] Du K, Mu X Y, Yu D B, et al. Synthesis and nonlineary optiacal propreties of high quality tenary Cd₃Pb₁₋₃Se quantum dots[J]. Infrated and Laser Engineering, 2015, 44 (5): 1549-1553.